

トランジスタ

T-33-11 2SD858, 2SD858A

2SD858, 2SD858A

シリコン NPN 三重拡散プレーナ形 / Si NPN Triple Diffused Planar

低周波電力増幅用 / AF Power Amplifier

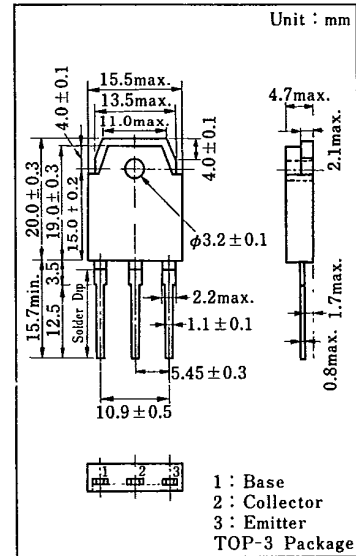
2SB763, 2SB763A とコンプリメンタリ / Complementary Pair with 2SB763, 2SB763A

■ 特徴 / Features

- コレクタ損失 P_C が大きい。 / Large P_C
- 直流電流増幅率 h_{FE} の直線性がよい。 / Good linearity of h_{FE}
- 安定化電源に最適です。 / Suitable for voltage regulator

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	60	V
2SD858A		80	
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	60	V
2SD858A		80	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	10	A
コレクタ電流	I_C	5	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	P_C	60	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ しゃ断電流	I_{CEO}	$V_{CE} = 30\text{ V}, I_B = 0$			700	μA
2SD858A		$V_{CE} = 60\text{ V}, I_B = 0$			700	
コレクタ しゃ断電流	I_{CES}	$V_{CE} = 60\text{ V}, V_B = 0$			400	μA
2SD858A		$V_{CE} = 80\text{ V}, V_{BE} = 0$			400	
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 5\text{ V}, I_C = 0$			1	mA
コレクタ・ エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C = 30\text{ mA}, I_B = 0$	60			V
2SD858A			80			V
直流電流増幅率	h_{FE1}^*	$V_{CE} = 4\text{ V}, I_C = 1\text{ A}$	40		250	
	h_{FE2}	$V_{CE} = 4\text{ V}, I_C = 3\text{ A}$	20			
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE} = 4\text{ V}, I_C = 3\text{ A}$			1.6	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 5\text{ A}, I_B = 0.5\text{ A}$			1.5	V
ターンオン時間	t_{on}	$I_C = 6\text{ A}, I_{B1} = -I_{B2} = 0.6\text{ A}$		0.2		μs
ターンオフ時間	t_{off}			1.4		μs

* h_{FE1} ランク分類 / h_{FE1} Classifications

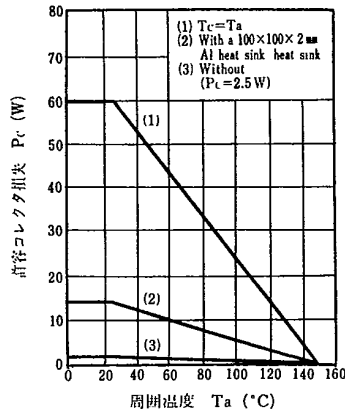
Class	R	Q	P
h_{FE1}	40 ~ 90	70 ~ 150	120 ~ 250

トランジスタ

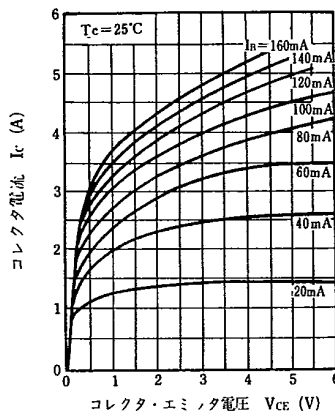
T-33-11

2SD858, 2SD858A

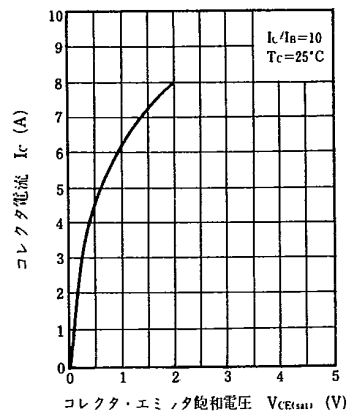
$P_C - T_a$



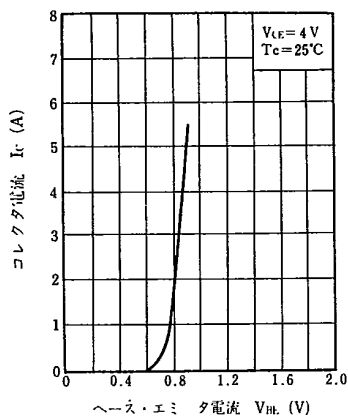
$I_C - V_{CE}$



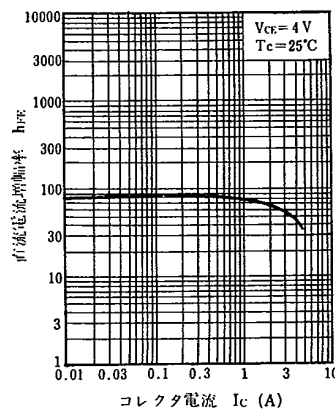
$I_C - V_{CE(sat)}$



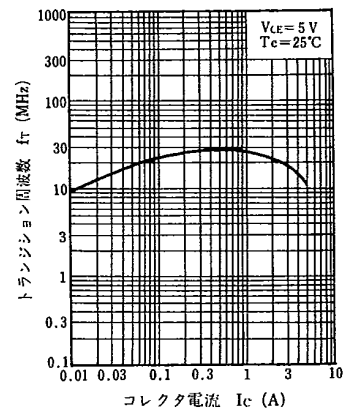
$I_C - V_{BE}$



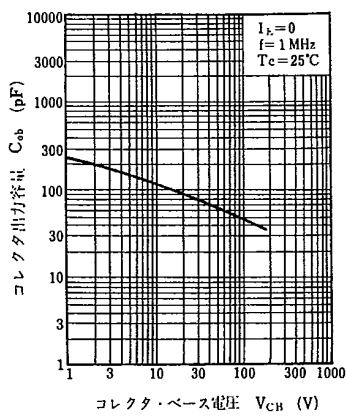
$h_{FE} - I_C$



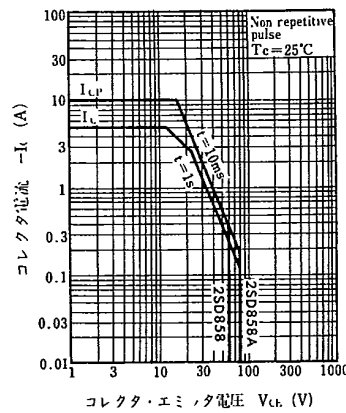
$f_T - I_C$



$C_{ob} - V_{CB}$



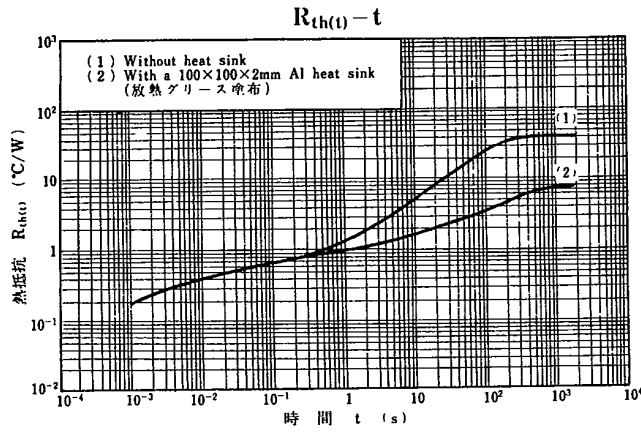
安全動作領域 ASO



トランジスタ

T-33-11

2SD858, 2SD858A



トランジスタ

T-33-11

2SD859, 2SD859A

2SD859, 2SD859A

シリコン NPN 三重拡散プレーナ形 / Si NPN Triple Diffused Planar

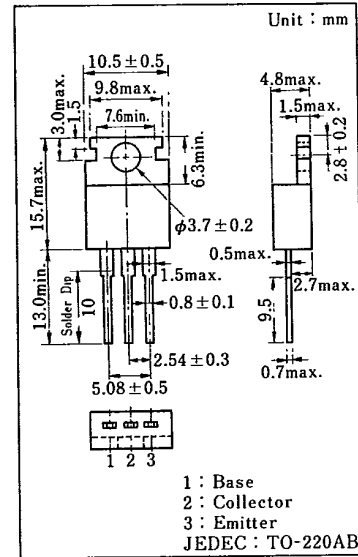
低周波電力増幅用 / AF Power Amplifier

■ 特徴 / Feature

- コレクタ・ベース電圧 V_{CBO} が高い。 / High V_{CBO}

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	2SD859 350	V
2SD859A 400			
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	2SD859 250	V
2SD859A 300			
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	1.5	A
コレクタ電流	I_C	0.75	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	P_c	35	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ シャ断電流	I_{CES}	$V_{CE} = 350\text{ V}, V_{BE} = 0$			1	mA
		$V_{CE} = 400\text{ V}, V_{BE} = 0$			1	
コレクタ シャ断電流	I_{CEO}	$V_{CE} = 150\text{ V}, I_B = 0$			1	mA
		$V_{CE} = 250\text{ V}, I_B = 0$			1	
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 5\text{ V}, I_C = 0$			1	mA
コレクタ・ エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C = 30\text{ mA}, I_B = 0$	250			V
			300			
直流電流増幅率	h_{FE1}^*	$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 0.3\text{ A}$	40		250	
	h_{FE2}	$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 1\text{ A}$	10			
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 1\text{ A}$			1.5	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 1\text{ A}, I_B = 0.2\text{ A}$			1	V
ターンオン時間	t_{on}	$I_C = 1\text{ A}, I_{B1} = -I_{B2} = 0.1\text{ A}$		0.2		μs
ターンオフ時間	t_{off}			2		μs

* h_{FE1} ランク分類 / h_{FE1} Classifications

Class	R	Q	P
h_{FE1}	40 ~ 90	70 ~ 150	120 ~ 250



LittleDiode supplies new, hard to find or obsolete electronic components and semiconductors all over the world.

With over two million different components listed you are sure to find the part you need.

Feel free to visit us today at our online store:

LittleDiode.com

Looking forward to providing you with the best possible service.